Integrált áramköri alkalmazásra szánt Cu-Mn vékonyrétegek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai

Az integrált áramköri kontaktus és összekötővezeték-alkalmazásokban is perspektivikus Cu-20 at% Mn-ötvözet vékonyréteg-szerkezete és mechanikai tulajdonságai közötti összefüggéseket vizsgáltuk transzmissziós elektronmikroszkópia és nanoindentációs mérések segítségével. A DC magnetron porlasztással előállított réteg oszlopszerű, ~15 nm átmérőjű, a hordozóra merőleges Cu(Mn) szilárdoldat szemcsékből áll, melyek szemcsehatárán amorf Cu-Mn található. A nanoindentációs benyomat helyén az oszlopok töredezetté váltak, bennük számos síkhiba látható. Meghatároztuk a réteg mechanikai tulajdonságait: a réteg keménysége 12,6 GPa, Young-modulusza 99 GPa, rugalmas regenerációjának mértéke 51%. A két fő szilárdságnövelő mechanizmusnak a Frank–Read-források nehezített működését és a Hall–Petch-effektust találtuk.

1. Bevezetés

Az egyre nagyobb teljesítményű mikroelektronikai eszközök fejlesztése a gyártási technológia területén is jelentős újításokat követel. Az integrált áramkörök esetében a fejlesztés egyik fő problémája az egyre kisebbé váló (a modern áramkörökben 20 nm körüli) áramköri elemek vezetékezésének megoldása. A vezetékeket a félvezető- és szigetelő elemektől egy ún. barrier réteg választja el, ami megakadályozza a vezetékek anyagának diffúzióját a környező egységekbe. A hagyományos eljárás során Ta/TaN barriert alkalmaznak, azonban ennek vastagságát nem lehet a kisebb vonalszélességek eléréséhez szükséges 5 nm alá csökkenteni. Újfajta barrier kialakítására az ún. önszerveződő rétegek alkalmazása

adhatna lehetőséget. Az önszerveződő barrier alapötlete, hogy a vezeték anyagát egy erős oxidképző elemmel ötvözik, amely az előállítás során (pl. hőkezelés hatására) a vezeték/dielektrikum határfelületire kiválva diffúziógátló határfelületi réteget képezne [1]. A korábbi kutatások alapján a Mn ígéretes ötvözőnek bizonyult és számos kutatás vizsgálta a barrier képződést SiO₂ felületén [1, 2].

Az alkalmazások szempontjából fontosak a Cu-Mn vékonyréteg-rendszer mechanikai tulajdonságai is. A mikroelektronikában alkalmazott rétegeknek komoly mechanikai követelményeknek kell megfelelniük. Mind a réteg, mind a réteg–hordozó kapcsolata a gyártás során dinamikus és koptató igénybevételnek van kitéve. Az eszközök működése során pedig a feszültség okozta üregképződés az

Hajagos-Nagy Klára 2013-ban szerezte meg MSc-diplomáját a BME Gépészmérnöki Karán. Jelenleg az Anyagtudomány és Technológia Tanszék doktorandusz hallgatója, kutatását az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Vékonyréteg-fizika osztályán végzi. Kutatásaiban ötvözet vékonyrétegek mikroszerkezetét, mechanikai és elektromos tulajdonságait vizsgálja.

Misják Fanni fizikusként szerzett MSc-diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2010-ben az ELTE Fizika Doktori Iskolájában PhD-fokozatot kapott. Jelenleg az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Fő kutatási területe az ötvözet vékonyrétegek kialakulási mechanizmusainak vizsgálata az előállítási paraméterek függvényében és a szerkezet-fizikai tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárása. Intenzíven alkalmazza az elektronmikroszkópia nyújtotta lehetőségeket mind a vékonyréteges, mind más anyagtudományi problémák megoldását célzó kutatásokban. egyik fő tönkremeneteli forma [3]. Az irodalomban a Cu-Mn vékonyrétegrendszerről kevés mechanikai vizsgálat található. Megvizsgálták azonban a Cu-Mn réteg hordozóhoz történő tapadását [1, 4]. A tiszta Cu könynyen leválik a SiO2-ról, ugyanezt tapasztalták az egyszerűen felvitt Cu-Mn rétegek esetén is. A barrier kialakulása után azonban a tapadás nagymértékben megjavult. A kiváló tapadás magyarázata, hogy a létrejövő alrétegek nem rendelkeznek éles határfelülettel, valamint a barrier kialakulása során kémiai (kovalens) kötések jönnek létre a határfelületeken keresztül.

A Cu-Mn ötvözet kontaktus anvagként való alkalmazhatóságának megismeréséhez, valamint a megfelelő előállítási paraméterek meghatározásához fontos lehet az egész anyagrendszert alaposabban feltérképezni. Ennek terén még hiányosságok vannak az irodalomban: a Cu-Mn ötvözet vékonvrétegek mechanikai tulaidonságai, illetve a mikroszerkezet hatása a mechanikai tulajdonságokra a teljes összetételskálán még felderítetlen terület. Jelen cikkben, egy kísérletsorozat első részeként 20 at% Mntartalmú Cu-Mn vékonyréteg mechanikai tulajdonságait vizsgáljuk, külön figyelmet fordítva a szilárdságnövelésben szerepet játszó mechanizmusok megismerésére.

2. Alkalmazott anyagok és kísérleti módszerek

A Cu-Mn vékonyrétegeket egyenáramú (DC) magnetronos porlasztással növesztettük ultranagy vákuumú berendezésben. A háttérvákuum < $1\cdot10^{-5}$) *Pa* volt, porlasztógázként Ar-gázt használtunk $2\cdot10^{-1}Pa$ nyomáson. A kétkomponensű rétegekhez a két targetet (99,999% tisztaságú Cu és 99,95% tisztaságú Mn) külön magnetron forrásba helyeztük. A hordozó Si egykristályon lévő termikus SiO₂ volt. A rétegek kívánt összetételét a két komponens növekedési sebességének szabályozásával értük el, ami a gyakorlatban a magnetronok teljesítményének megfelelő beállítását jelentette [5]. A vizsgálandó 20 at% Mn-tartalmú rétegen kívül két referenciaréteget készítettünk: 100 at% Cu- és 100 at% Mn-tartalommal. Minden réteget szobahőmérsékleten növesztettünk, és vastagságuk egységesen ~1 µm volt. A rétegek növekedési sebességét ~0,3-0,4 nm/s-nak választottuk.

A rétegek mechanikai tulajdonságait nanoindentációs méréssel vizsgáltuk. A fel-leterhelési görbéket Berkovich-indentorral vettük fel Micro Materials Nanotest 600 típusú berendezésen az ELTE TTK Anyagfizika Tanszéken. A kapott benyomódás (h) - terhelőerő (P) görbékből a keménység és a rugalmassági modulus meghatározását az Oliver--Pharrmódszer [6] alapján végeztük. A hordozóhatás kiküszöbölésére a maximális benyomódást a rétegvastagság tizedére korlátoztuk [7]. A terhelőerő 10—2500 µN tartományban mozgott, a terhelési sebesség ~5-10 nm/s volt. Minden mintán 50, egymástól 1 µm távolságra elhelyezkedő pontban történt mérés. Eredményként a mérési pontokra egyesével kiszámolt értékek számtani középértékét fogadtuk el.

A Cu-Mn rétegek mikroszerkezetének vizsgálatát transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) segítségével végeztük. Az itt bemutatott mikroszkópos és diffrakciós vizsgálatok egy 200 keV-on működő Philips CM-20

és egy 300 keV-on működő JEOL-3010 elektronmikroszkóppal történtek. Az indentációs benyomat környezetének szerkezetét bemutató metszetek fókuszált ionnyaláb (FIB) technika alkalmazásával készültek [8]. A határolt területű diffrakciós felvételeket a Process Diffraction [9] programmal értékeltük ki.

3. Eredmények és kiértékelésük

Az 1a ábrán a 20 at% Mn-tartalmú réteg keresztmetszeti



1. ábra. A 20 at% Mn-tartalmú minta és az indentációs benyomat keresztmetszete.
a) világos látóterű átnézeti kép, b) a réteg diffrakciója

TEM-képe látható. A felvétel egy FIBtechnikával kivágott lamelláról készült, a vágás egy indentációs benyomat középső síkjában történt a hordozóra merőlegesen. Megfigyelhető a benyomat geometriája: a benyomat két oldalegyenese a terhelés irányával ~65°- és ~77°-os szöget zár be, ami megfelel a Berkovich-indentor alakjának. A képen a hordozóra merőlegesen növekedő oszlopszerű szemcséket figyelhetünk meg. A szemcsék mérete: 100-150 nm hoszszú oszlopok, átmérőjük ~15 nm. A rétegvastagságnál jelentősen rövidebb szemcsék jelenléte arra utal, hogy a szemcsék növekedését egy a felületükön képződő záróréteg megakadályozta és ennek felületén új oszlopos szemcsék kezdtek növekedni. Ez a jelenség az ismételt magképződés, amely egy kisebbségi második fázis kialakulásának tulajdonítható [10]. A második fázis a szemcsék felületén helyezkedik el, korábbi munkánk során amorf Cu-Mn-ként azonosítottuk [5]. Az 1a ábrán az osz-





lophatárok világos kontrasztja sejteti a szemcsehatárokon lévő amorf fázis jelenlétét. Az *1b ábrán* a réteg diffrakciója látható, a diffrakciós maximumok az fkk kristályszerkezetre jellemzőek.

A benyomat alatti területet vizsgálva a deformáció nyoma az oszlopszerkezetben mintegy 0,4 µm mélységig figyelhető meg (az 1a ábrán szaggatott vonallal körbevett terület). Ebben a térfogatban az oszlopok összetöredeztek. A deformált térfogat a rétegvastagság felső 2/5 részét öleli fel, így hordozóhatással a keménységmérések kiértékelésekor nem kell számolnunk.

A rétegen végzett nanoindentációs mérések egy tipikus erő-elmozdulás (*P*(*h*)) görbéje látható a 2. ábrán. A felterhelési szakaszban rugalmas és képlékeny alakváltozás megy végbe, a két tartomány határa nem jelölhető ki. A leterhelési szakaszban az anyag rugalmasan relaxál, szaggatott vonal jelöli a kezdeti meredekséget, melynek segítségével a rugalmassági

modulus számítható.

Az 1. táblázatban összehasonlíthatjuk a 20 at% Mnréteg és a két referencia réteg (Cu és Mn) mechanikai tulajdonságait: a rétegek erő-elmozdulás P(h) görbéiből számított keménység (H), rugalmassági modulus (E), H/E hányados és rugalmas regeneráció ($\varepsilon_{rug} / \varepsilon_{képl}$) értékeket. A Cu-réteg keménysége (4,1 GPa) jó egyezést mutat az irodalomban található hasonló vastagságú Cu-rétegen mért 3,8 GPa-os értékkel [11]. 20 at% Mn-tartalomnál a keménység a Cu értékéhez képest háromszorosára nő (12,6 GPa), ami feltételezhetően több szilárdságnövelő mechanizmus együttes eredménye. A Cu-réteg modulusa (101,7 GPa) több irodalmi adattal is megfelelő egyezést mutat [12, 13], a 20 at% Mn-tartalmú minta modulusa (99 GPa) pedig a Cu-réteg modulusának nagyságrendjébe esik. A nanoindentációs mérésekből meghatározható két gyártástechnológiai szempontból is fontos arányszám: a H / E hányados és a rugalmas regeneráció mértéke ($\varepsilon_{rug} / \varepsilon_{képl}$). A *H* / *E* hányados a réteg kopásállóságáról ad információt [14], jellemzően a 0,1 fölötti értékeket tartják megfelelőnek, ennek a 20 at% Mn-tartalmú réteg megfelel (1. táblázat). A rugalmas regeneráció mértéke közvetetten információt ad a maradó alakváltozásról, ami a gyártás során előforduló folyáshatárt meghaladó igénybevételek miatt fontos. A számított értékek alapján a 20 at% Mn-tartalmú réteg háromszoros rugalmas regenerálódásra képes a Cu-réteghez viszonyítva (1. táblázat).

A TEM-felvételeken megfigyelt morfológiák segítségével meghatározhatjuk, mely szilárdságnövelő mechanizmusoknak tulajdonítható a 20 at% Mn ötvözéssel elért 8,5 GPaos keménységnövekedés. Mivel ezek a mechanizmusok egymással párhuzamosan működnek, így hatásuk összegezhető:

$$H = H_{Cu} + \sum \Delta H_i = H_{Cu} + \Delta H_{sz} + \Delta H_d + \Delta H_{E-R} + \Delta H_2$$
(1)

ahol H a mért keménység, H_{Cu} a Cu referenciaréteg keménysége, ΔH_{sz} a szilárd oldatos keményítés, ΔH_D a szemcseméret csökkentése, ΔH_{F-R} a Frank–Read-források nehezített működése és $\Delta H_{2.f}$ a második fázis által létrehozott keménységnövekedés.

Szilárdoldatos keményítésnél homogén ötvözetkoncentráció esetén az ötvözet szilárdsága a következő módon növekszik [15]:

$$\Delta \sigma = G_{Cu} \cdot \varepsilon^2 \cdot X_{Mn} \tag{2}$$
$$\varepsilon = \frac{r_{Cu} - r_{Mn}}{r_{Cu}} \tag{3}$$

ahol G_{Cu} a Cu nyírási modulusa, X_{Mn} a Mn atomhányada, ε a rácsban keltett rugalmas deformáció és r az adott elem atomsugara. A szilárdság változására a (2) és (3) képletek alapján, G_{Cu} = 48 GPa, X_{Mn} = 0,25, r_{Cu} = 0,128 nm [16] és r_{Mn} = 0,127 nm [17] értékek mellett $\Delta \sigma$ = 0,73 MPa-t kapunk. A folyáshatár és keménység között háromszoros szorzót feltételezve a szilárd oldatos keményedés ∆H_{sz} = 2,2 MPa növekményt okoz a keménységben, ami három nagyságrenddel kisebb a Cu és a 20 at% Mntartalmú réteg közötti 8,5 GPa keménységnövekedésnél. Így a szilárdoldatos keményítés szerepe elhanyagolható.

A szemcseméret csökkenésével a határok fajlagos felülete megnövekszik, így az anyagot felépítő atomoknak nagyobb hányada vesz részt a diszlokációk megállításában. A szemcsefinomítás szilárdságnövelő hatását Hall [18] és Petch [19] mérte meg. A keménységre felírt összefüggés:

$$H_{H-P} = H_0 + \frac{h}{\sqrt{d}} = H_0 + \Delta H_d \tag{4}$$

ahol H_{H-P} a polikristály keménysége, H_0 az egykristály keménysége, da jelentős diszlokáció mozgás irányába vett karakterisztikus szemcseméret és h a szemcsehatár ellenállását jellemző akadályozási paraméter. Nanokristályos Cu-re meghatározott h = 316 MPa $\sqrt{\mu}m$ [20] értékkel számolva d = 15 nm esetén a szemcseméret-csökkenés ΔH_d =2,6 GPa keménységnövekedést eredményez a tiszta Cu egykristályhoz képest. Tehát a 8,5 GPa-os keménységnövekedés kb. 1/3-a a szemcseméret csökkenésének tulajdonítható.

Nanoszemcsés anyagoknál a Frank–Read-források nehezített működése is szerepet játszhat a szilárdságnövelésben. Ahogy a szemcseméret egy nagyságrendbe kerül a diszlokációforrások méretével, a források megindítása egyre nehezebbé válik, ami növeli a szilárdságot és csökkenti az alakíthatóságot. A Frank-Read-források méretének szemcseméret miatti csökkenésével a hurkok kibocsátásához szükséges feszültség az (5) képlet alapján növekszik [21]:

$$\tau = \frac{2 \cdot G_{Cu} \cdot b}{x} \tag{5}$$

ahol *T* a forrás megindításához szükséges nyírófeszültség, G_{Cu} a Cu nyírási modulusza, b a Burgers-vektor mérete és x a diszlokációt megkötő két akadály távolsága. A Burgersvektor mérete a rácsállandóból (a = 0,3677 nm az 1b diffrakcióból kiértékelve) számítható: b=a/√2=0,26 nm (fkk rács esetén). Esetünkben a két akadály a két szemcsehatár, így x=d=15 nm. G_{Cu}=48 GPa [16], b=0,26 nm és x=15 nm értékekkel számolva a források megindításához szükséges nyírófeszültség T=1665 MPa. Ez alapján a Frank-Read-források nehezített működése $\Delta \sigma_{\text{F-R}} \cong 1,67$ GPa szilárdságnövekedést eredményez, ami háromszoros szorzót feltételezve $\Delta H_{F-R} \cong 5$ GPa keménységnövekedésnek felel meg.

Azonban a Frank-Read-források működése parciális diszlokációk révén is megvalósulhat. Erre utal, hogy a deformált térfogatban lévő szemcsékben (oszlopokban) jelentős számú síkhiba található. Egy ilyen területet láthatunk a 3. ábrán. Az ábrán nyilakkal jelölt lamellák vastagsága 5-8 darab (111) sík vastagságnak felel meg (kb. 1,1-1,7 nm), hoszszukat a kristály (oszlop) mérete korlátozza. A lamellák sűrűsége egyes szemcsékben eléri a 0,1 nm⁻¹-t, vastagságuk az egy atomrétegtől (~0,206 nm) általában 1-2 nm-ig terjed. A parciális diszlokációk Burgersvektora rövidebb, ezáltal a források megindításához szükséges feszültség is kisebb, (5) képlet.

Azonban a síkhibák képződéséhez szintén nyírófeszültségre van szükség, így a Frank–Read-források nehezített működése által okozott keménységnövekedés hozzávetőle-

1. táblázat. A Cu, a 20 at% Mn és a Mn-réteg mechanikai tulajdonságai

Összetétel	H [GPa]	H _{szórás} [GPa]	E[GPa]	$E_{sz \circ r \circ s}[GPa]$	H/E [-]	$\varepsilon_{rug}/\varepsilon_{k\acute{p}l}$ [-]
Cu	4,1	0,45	101,7	37,1	0,04	0,17
20 at% Mn	12,6	0,13	99,3	12,9	0,13	0,51
Mn	23,7	0,23	133,7	15,6	0,18	0,88



■ 3. ábra. A deformált terület egy kristályának nagy felbontású képe. A képen látható lamellák (fehér nyilakkal jelölve) a benyomathoz közeli tartományban helyezkednek el. Az ábrán fehér vonal jelöli az {111} típusú síkok nyomvonalát

gesen egyenlő teljes és parciális diszlokációk esetén.

A második fázis szilárdságnövelő szerepének feltárásához annak speciális elhelyezkedését kell figyelembe venni. A második fázis jelen esetben amorf Cu-Mn, ami a Cu(Mn) szilárdoldat szemcsék határán helyezkedik el, vastagsága 1-2 monoréteg [5]. Szilárdságnövelő hatását úgy fejti ki, hogy nehezíti a deformáció továbbvitelét a következő szemcsébe, azaz növeli a szemcsehatár ellenállását jellemző akadályozási paramétert (h), (4) képlet.

Az egyes mechanizmusok szilárdságnövelő hatását az (1) képlet szerint összegezve a 20 at% Mn-tartalmú réteg számított keménysége a szemcsehatármenti amorf fázis szilárdságnövelő hatása nélkül (H=11,7 GPa) elég jól közelíti a mért 12,6 GPa értéket. A számított és mért érték közötti 0,9 GPa különbség legalább részben a szemcsehatárokban lévő második fázis szilárdságnövelő hatásának tulajdonítható.

4. Összefoglalás

Szobahőmérsékleten DC magnetron porlasztással előállított 20 at% Mntartalmú Cu-Mn ötvözetréteg mechanikai és szerkezeti tulajdonságait vizsgáltuk. A lehetséges deformációs mechanizmusok feltárásához transzmissziós elektronmikroszkópiával vizsgáltuk egy nanoindentációs benyomat környezetét. A réteg ~15 nm

átmérőjű, oszlopszerű Cu(Mn) szilárd oldat szemcsékből állt, a kisebbségi amorf Cu-Mn fázis a szemcsehatárokon helyezkedett el. A benyomat közelében a szemcsék megtörtek, felismerhető volt a deformált térfogat határa a réteg felületétől kb. 0,4 µm mélységben. A deformált térfogatban jelentős számú síkhiba található, azaz a deformáció részben parciális diszlokációk mozgásával történt. A nanoindentációs mérések alapján meghatároztuk a réteg keménységét (12,6 GPa), rugalmassági moduluszát (99 GPa), H/E hányadosát (0,18) és rugalmas regenerációjának mértékét (51 %). Megállapítottuk, hogy a 20 at% Mn-nal történő ötvözés háromszorosára növeli a Cu keménységét és javít a Cu dinamikusés koptató igénybevételekkel szembeni ellenállásán. A keménység növekedése főként a ~15 nm-es szemcseméretnek köszönhető, egyrészt a Frank-Read-források nehezített működése, másrészt a Hall-Petch-effektus miatt. Ezen túlmenően a szemcsehatárokon jelen lévő vékony amorf réteg és ez által a Hall-Petchösszefüggésben szereplő h tényező növekedése is járulékot ad a keménység növekedéséhez.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetet mondanak az OTKA-K81808 és NN OTKA 112156 projektek keretében az MTA és a NKFIH által nyújtott támogatásoknak. Köszönet illeti *dr. Radnóczi Györgyöt* támogatásáért és hasznos tanácsaiért, *Illés Leventét* a FIB mintakészítésért, valamint az ELTE TTK Anyagfizika Tanszéket és *Szommer Pétert* a nanoindentációs mérésekben nyújtott segítségéért.

Irodalom

- Koike, J. & Wada, M. Self-forming diffusion barrier layer in Cu–Mn alloy metallization. Applied Physics Letters 87 (2005).
- [2] Lozano, J. G. et al. Interdiffusion and barrier layer formation in thermally evaporated Mn/Cu heterostructures on SiO₂ substrates. Applied Physics Letters 98 (2011).
- [3] Okabayashi, H. Stress-induced void formation in metallization for integrated circuits. Materials Science and Engineering: R: Reports 11, 191–241 (1993).

- [4] Gordon, R. G. Chemical Vapor Deposition (CVD) of Manganese Self-Aligned Diffusion Barriers for Cu Interconnections in Microelectronics. Adv Metall Conf (2008).
- [5] Misják, F., Nagy, K. H., Lobotka, P. & Radnóczi, G:. Electron scattering mechanisms in Cu-Mn films for interconnect applications. Journal of Applied Physics 116 (2014).
- [6] Oliver, W. C. & Pharr, G. M.: An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. Journal of Materials Research 7, 1564–1583 (1992).
- [7] Lichinchi, M., Lenardi, C., Haupt, J. & Vitali, R:. Simulation of Berkovich nanoindentation experiments on thin films using finite element method. Thin Solid Films 312, 240–248 (1998).
- [8] Giannuzzi, L. A. & Stevie, F. A.: A review of focused ion beam milling techniques for TEM specimen preparation. Micron 30, 197–204 (1999).
- [9] Lábár, J. L.: Consistent indexing of a (set of) single crystal SAED pattern(s) with the Process Diffraction program. Ultramicroscopy 103, 237–249 (2005).
- [10] Barna, P. B. & Adamik, M.: Fundamental structure forming phenomena of polycrystalline films and the structure zone models. Thin Solid Films 317, 27–33 (1998).
- [11] Zong, R. L., Wen, S. P., Zeng, F., Gao, Y. & Pan, F.: Nanoindentation studies of Cu–W alloy films prepared by magnetron sputtering. Journal of Alloys and Compounds 464, 544–549 (2008).
- [12] Read, D. T.: Tension-tension fatigue of copper thin films. International Journal of Fatigue 20, 203–209 (1998).
- [13] *Spaepen, F.:* Interfaces and stresses in thin films. Acta Materialia 48, 31–42 (2000).
- [14] Leyland, A. & Matthews, A.: Design criteria for wear-resistant nanostructured and glassy-metal coatings. Surface and Coatings Technology 177–178, 317–324 (2004).
- [15] Artinger, I.: Szilárdságnövelés lehetőségei (Kiadatlan egyetemi jegyzet).
- [16] Technical data for Cu, <http://periodic table.com/Elements/029/data.html> (2017.04.05.).
- [17] Technical data for Mn, <http://periodic table.com/Elements/025/data.html> (2017.04.05.).
- [18] Hall, E. O. The Deformation and Ageing of Mild Steel: III Discussion of Results. Proceedings of the Physical Society. Section B 64, 747 (1951).
- [19] Petch, N. J.: Cleavage Strength of Polycrystals. J Iron Steel Inst 174, 25 (1953).
- [20] Chen, J., Lu, L. & Lu, K.: Hardness and strain rate sensitivity of nanocrystalline Cu. Scripta Materialia 54, 1913–1918 (2006).
- [21] Verő, J.: Fémtan. 272 (Tankönyvkiadó, 1969).